

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【公開番号】特開2010-171243(P2010-171243A)

【公開日】平成22年8月5日(2010.8.5)

【年通号数】公開・登録公報2010-031

【出願番号】特願2009-12955(P2009-12955)

【国際特許分類】

H 01 L 21/82 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/82 B

H 01 L 21/82 D

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月29日(2011.11.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0038

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0038】

ゲートパッド部21Bは、ゲートパッド部21Aを180度回転移動した図形のパターンとなる。

よって、図1(B)と図1(C)に示すように、ゲートパッド部21Bにおいては、メタル配線交差部211の長辺途中からP型拡散層11Pと交差するように伸びるゲートフィンガー部22Bを、ゲート電極20Bが有する。基幹部212の端辺からN型拡散層11Nと交差するように伸びるゲートフィンガー部23Bを、ゲート電極20Bが有する。

ゲートフィンガー部22B, 23Bは、それらの幅がトランジスタの、いわゆるゲート長を規定する。ゲートフィンガー部22BがP型拡散層11Pと交差する部分の長さがPMOSトランジスタの、いわゆるゲート幅を規定する。ゲートフィンガー部23BがN型拡散層11Nと交差する部分の長さがNMOSトランジスタの、いわゆるゲート幅を規定する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0045】

P型拡散層11Pと交差するゲート電極20Aのゲートフィンガー部22Aをゲートとする、PMOSトランジスタが形成されている。PMOSトランジスタのソース領域が、1stコンタクト41(1C)に接続されたP型拡散層部分に形成されている。一方、ゲートフィンガー部22Aを挟んで、1stコンタクト41(1C)に接続されたP型拡散層部分と反対側のP型拡散層部分が、PMOSトランジスタのドレイン領域となる。

PMOSトランジスタのドレイン領域に2つの1stコンタクト43(1C), 44(1C)が形成されている。